

DS90CR218A

*DS90CR218A +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 21-Bit Channel Link - 12 MHz
to 85 MHz*



Literature Number: JAJ670



2006年10月

DS90CR218A

+ 3.3V 立ち上がりエッジ・データ・ストローク 21-Bit Channel Link-12 ~ 85MHz

概要

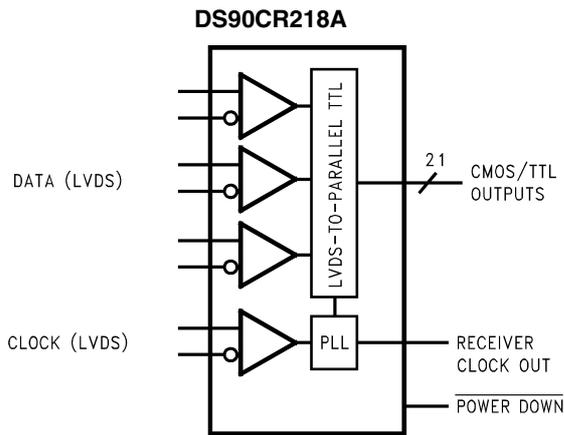
DS90CR218A レシーバは、3 対の LVDS 入力データ・ストリームを 21 ビットの CMOS/TTL 出力データにデシリアライズします。最大入力クロック周波数の 85MHz で動作すると、データ・チャンネルごとに 595Mbps で LVDS データが受信され、総データスレーブットは 1.785Gbit/sec (233MB/sec) となります。

バス幅が狭く LVDS 信号を利用する DS90CR218A は、広帯域かつ高速の TTL インタフェースに付随する EMI とケーブル・サイズの問題を解決できる理想的な手段です。

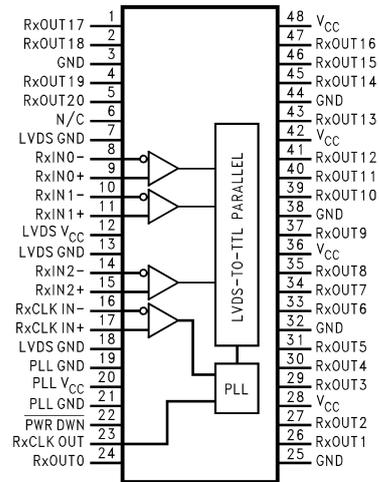
特長

- 12 ~ 85MHz クロックに対応
- 50%デューティ・サイクルのレシーバ・クロック出力
- 低消費電力
- ± 1V コモンモード・レンジ (+ 1.2V 中心)
- バス幅の低減によるケーブルの小型化、コスト削減が可能
- データ・スレーブット 1.785Gbit/s (max)
- 223Mbytes/s の高速転送
- 低 EMI を実現する 345mV (typ) 信号振幅
- PLL は外付け部品不要
- 立ち上がりエッジ・データ・ストローク
- TIA/EIA-644 LVDS 標準準拠
- 高密度実装を可能にする 48 ピン TSSOP パッケージ

ブロック図



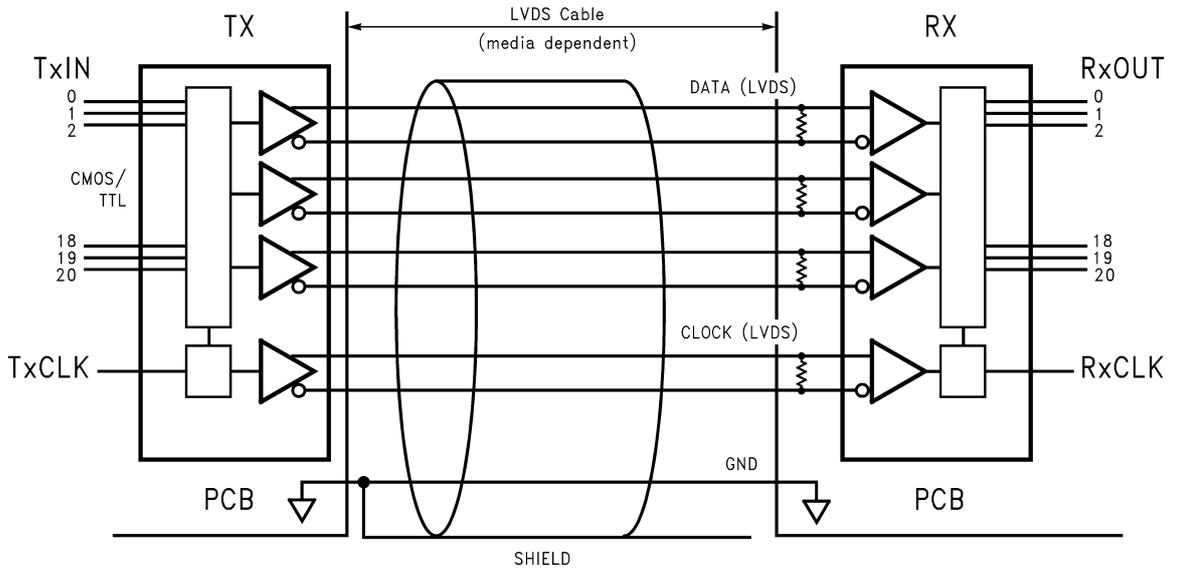
ピン配置図



DS90CR218A

DS90CR218A + 3.3V 立ち上がりエッジ・データ・ストローク 21-Bit Channel Link-12 ~ 85MHz

代表的なアプリケーション



絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

電源電圧 (V_{CC})	- 0.3V ~ + 4V
CMOS/TTL 入力電圧	- 0.5V ~ ($V_{CC} + 0.3V$)
CMOS/TTL 出力電圧	- 0.3V ~ ($V_{CC} + 0.3V$)
LVDS レシーバ入力電圧	- 0.3V ~ ($V_{CC} + 0.3V$)
LVDS ドライバ出力電圧	- 0.3V ~ ($V_{CC} + 0.3V$)
PN 接合温度	+ 150
保存温度範囲	- 65 ~ + 150
許容リード温度 (ハンダ付け 4 秒)	+ 260
最大パッケージ許容損失 (+ 25 のとき)	
MTD48 (TSSOP) パッケージ:	
DS90CR218A	1.89 W

* 周囲温度 + 25 を超える場合は、

DS90CR218A	15 mW/
を減じてください。	
ESD 耐圧	
(HBM, 1.5k 、 100pF)	> 7kV
(EIAJ, 0 、 200pF)	> 700V
25 におけるラッチアップ耐圧	> ± 300mA

推奨動作条件

	最小値	標準値	最大値	単位
電源電圧 (V_{CC})	3.0	3.3	3.6	V
動作周囲温度 (T_A)	- 10	+ 25	+ 70	
レシーバ入力電圧範囲	0		2.4	V
電源ノイズ電圧 (V_{CC})			100	mV _{pp}

電気的特性

特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および動作温度範囲に対して適用。

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units	
CMOS/TTL DC SPECIFICATIONS							
V_{IH}	High Level Input Voltage		2.0		V_{CC}	V	
V_{IL}	Low Level Input Voltage		GND		0.8	V	
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_{OH} = -0.4$ mA	2.7	3.3		V	
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_{OL} = 2$ mA		0.06	0.3	V	
V_{CL}	Input Clamp Voltage	$I_{CL} = -18$ mA		-0.79	-1.5	V	
I_{IN}	Input Current	$V_{IN} = 0.4V, 2.5V$ or V_{CC}		+1.8	+15	μ A	
		$V_{IN} = GND$	-10	0		μ A	
I_{OS}	Output Short Circuit Current	$V_{OUT} = 0V$		-60	-120	mA	
LVDS RECEIVER DC SPECIFICATIONS							
V_{TH}	Differential Input High Threshold	$V_{CM} = +1.2V$			+100	mV	
V_{TL}	Differential Input Low Threshold		-100			mV	
I_{IN}	Input Current	$V_{IN} = +2.4V, V_{CC} = 3.6V$			±10	μ A	
		$V_{IN} = 0V, V_{CC} = 3.6V$			±10	μ A	
RECEIVER SUPPLY CURRENT							
I_{CCRW}	Receiver Supply Current Worst Case	$C_L = 8$ pF, Worst Case Pattern (Figures 1, 2)	$f = 33$ MHz		49	60	mA
			$f = 40$ MHz		53	65	mA
			$f = 66$ MHz		78	100	mA
			$f = 85$ MHz		90	115	mA
I_{CCRZ}	Receiver Supply Current Power Down	PWR DWN = Low Receiver Outputs Stay Low during Powerdown Mode		140	400	μ A	

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この範囲を超えるとデバイスの安全性が保証されないリミット値をいり、これらのリミット値でデバイスが動作することを意味するものではありません。「電気的特性」の表にデバイスの実動作条件を記載しています。

Note 2: 代表値 (Typ) はすべて $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = +25$ で得られる最も標準的な数値です。

Note 3: デバイス・ピンに流れ込む電流は正、デバイス・ピンから流れ出る電流は負と定義されます。 V_{OD} と V_{OD} 以外、すべての電圧値はグラウンド・ピンを基準とします。

レシーバスイッチング特性

特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および動作温度範囲に対して適用。

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Units	
CLHT	CMOS/TTL Low-to-High Transition Time (Figure 2)		2.0	3.5	ns	
CHLT	CMOS/TTL High-to-Low Transition Time (Figure 2)		1.8	3.5	ns	
RSPos0	Receiver Input Strobe Position for Bit 0 (Figure 8)	f = 85 MHz	0.49	0.84	1.19	ns
RSPos1	Receiver Input Strobe Position for Bit 1		2.17	2.52	2.87	ns
RSPos2	Receiver Input Strobe Position for Bit 2		3.85	4.20	4.55	ns
RSPos3	Receiver Input Strobe Position for Bit 3		5.53	5.88	6.23	ns
RSPos4	Receiver Input Strobe Position for Bit 4		7.21	7.56	7.91	ns
RSPos5	Receiver Input Strobe Position for Bit 5		8.89	9.24	9.59	ns
RSPos6	Receiver Input Strobe Position for Bit 6		10.57	10.92	11.27	ns
RSKM	RxIN Skew Margin (Note 4) (Figure 9)	f = 85 MHz		0.49		ns
		f = 12MHz		2.01		ns
RCOP	RxCLK OUT Period (Figure 3)	11.76	T	83.33	ns	
RCOH	RxCLK OUT High Time (Figure 3)	f = 85 MHz	4	5	6.5	ns
RCOL	RxCLK OUT Low Time (Figure 3)		3.5	5	6	ns
RSRC	RxOUT Setup to RxCLK OUT (Figure 3)		3.5			ns
RHRC	RxOUT Hold to RxCLK OUT (Figure 3)		3.5			ns
RCCD	RxCLK IN to RxCLK OUT Delay @ 25°C, V _{CC} = 3.3V (Note 5)(Figure 4)		5.5	7	9.5	ns
RPLLS	Receiver Phase Lock Loop Set (Figure 5)			10	ms	
RPDD	Receiver Powerdown Delay (Figure 7)			1	μs	

Note 4: V_{OS} は以前は V_{CM} と表記されていました。このマージンは、レシーバの入力セットアップ / ホールドタイム (内部のデータ・サンプリング・ウインドウ) を考慮しています。トランスミッタのバリス位置 (TPPOS) のばらつきは考慮しておらず、理想的な TPPOS を使用して測定されています。このマージンは、LVDS 配線スキューおよび符号間干渉 ISI (いずれもケーブル長とケーブル種に依存)、トランスミッタのバリス位置 (TPPOS) のばらつき、250ps 未満のソース・クロック・ジッタにより消費されます。

Note 5: チャンネルリンク・チップセット全体でのレイテンシは、クロック周期、およびトランスミッタ (TCCD) とレシーバ (RCCD) のゲート・ディレイの関数として表されます。トランスミッタDS90CR217/287とレシーバDS90CR218A/288Aのレイテンシの合計は、Tをクロック周期としたとき、(T + TCCD) + (2*T + RCCD)となります。

AC タイミング図

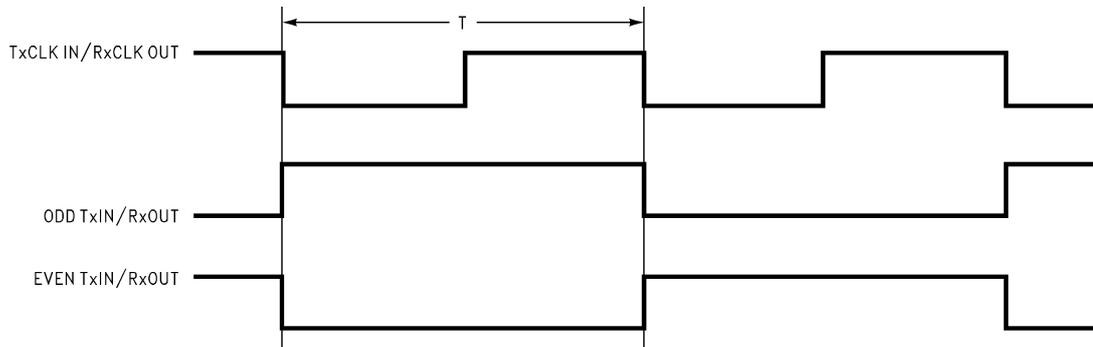


FIGURE 1. "Worst Case" Test Pattern

AC タイミング図 (つづき)

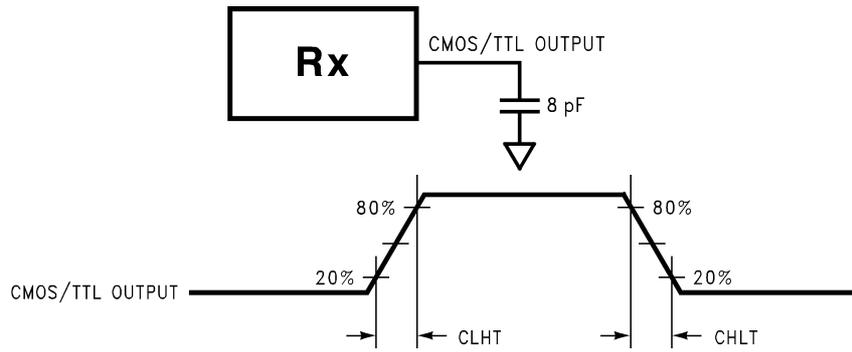


FIGURE 2. DS90CR218A (Receiver) CMOS/TTL Output Load and Transition Times

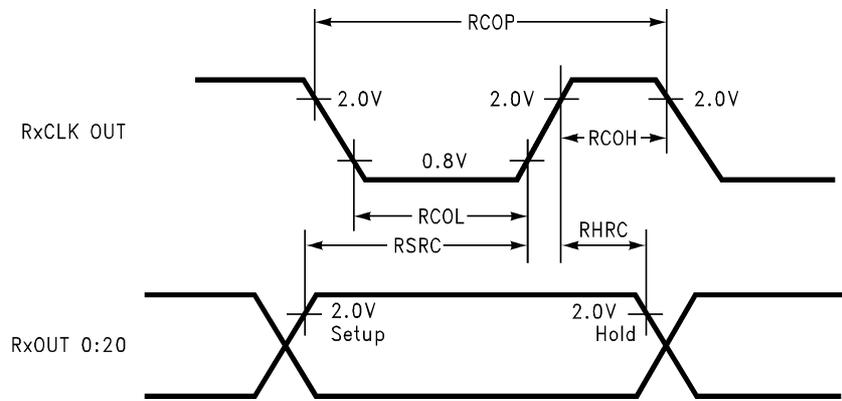


FIGURE 3. DS90CR218A (Receiver) Setup/Hold and High/Low Times

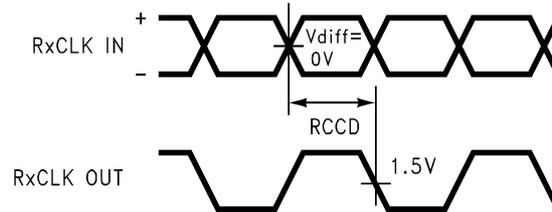


FIGURE 4. DS90CR218A (Receiver) Clock In to Clock Out Delay

AC タイミング図 (つづき)

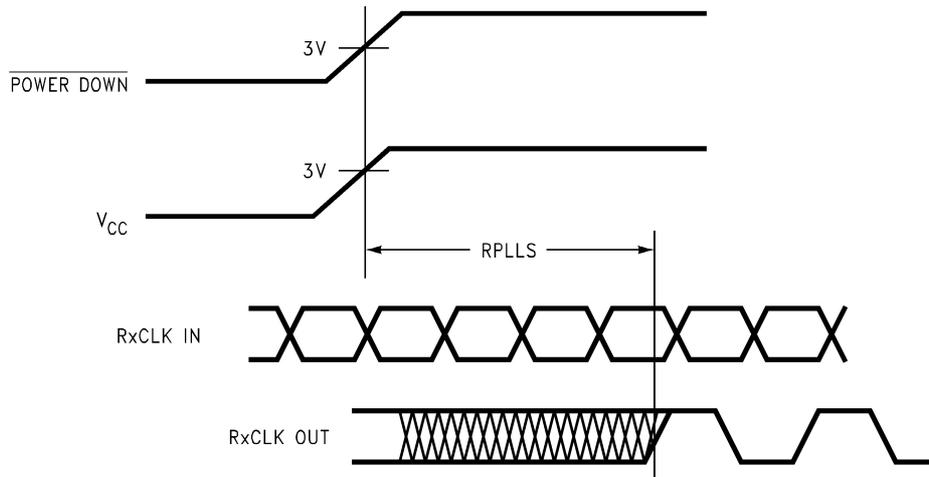


FIGURE 5. DS90CR218A (Receiver) Phase Lock Loop Set Time

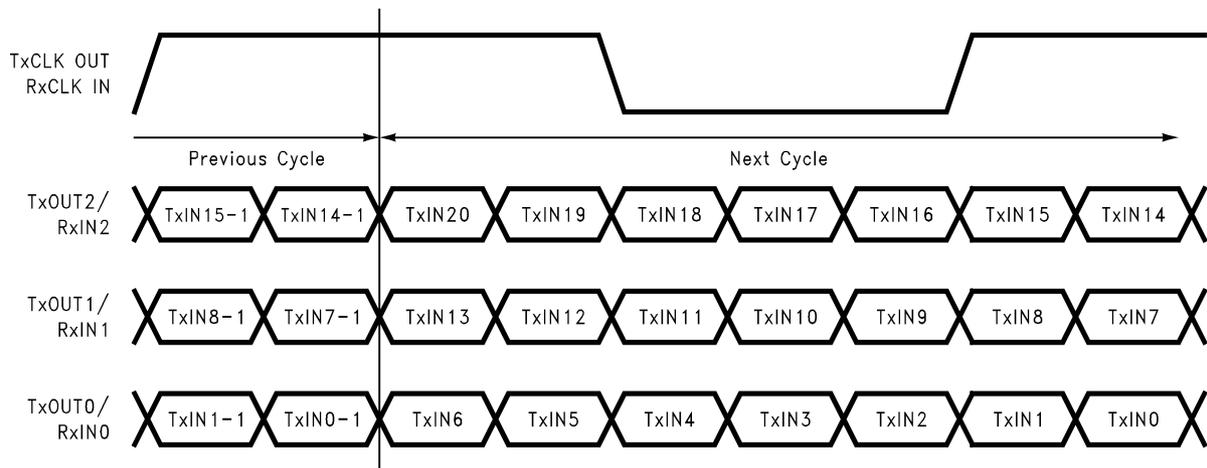


FIGURE 6. 21 Parallel TTL Data Inputs Mapped to LVDS Outputs (DS90CR217)

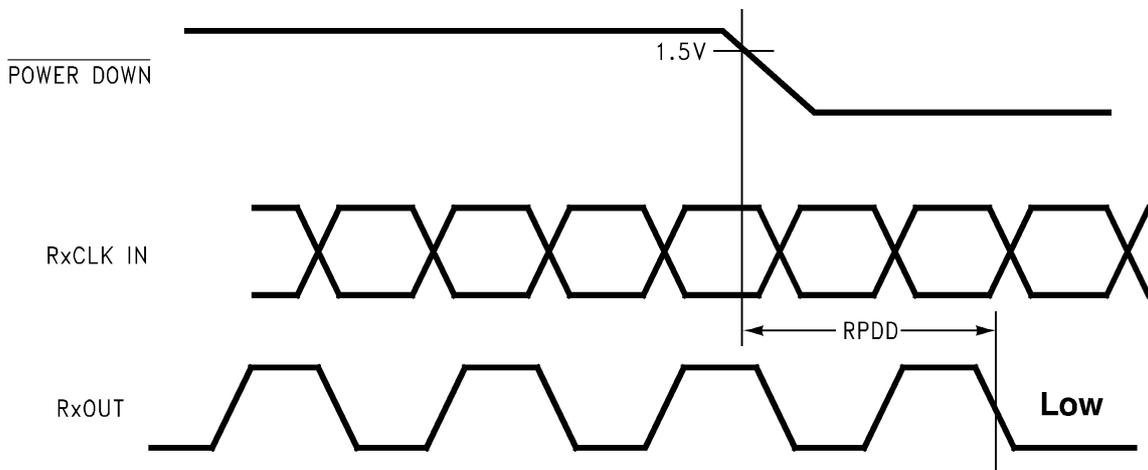


FIGURE 7. Receiver Powerdown Delay

AC タイミング図 (つづき)

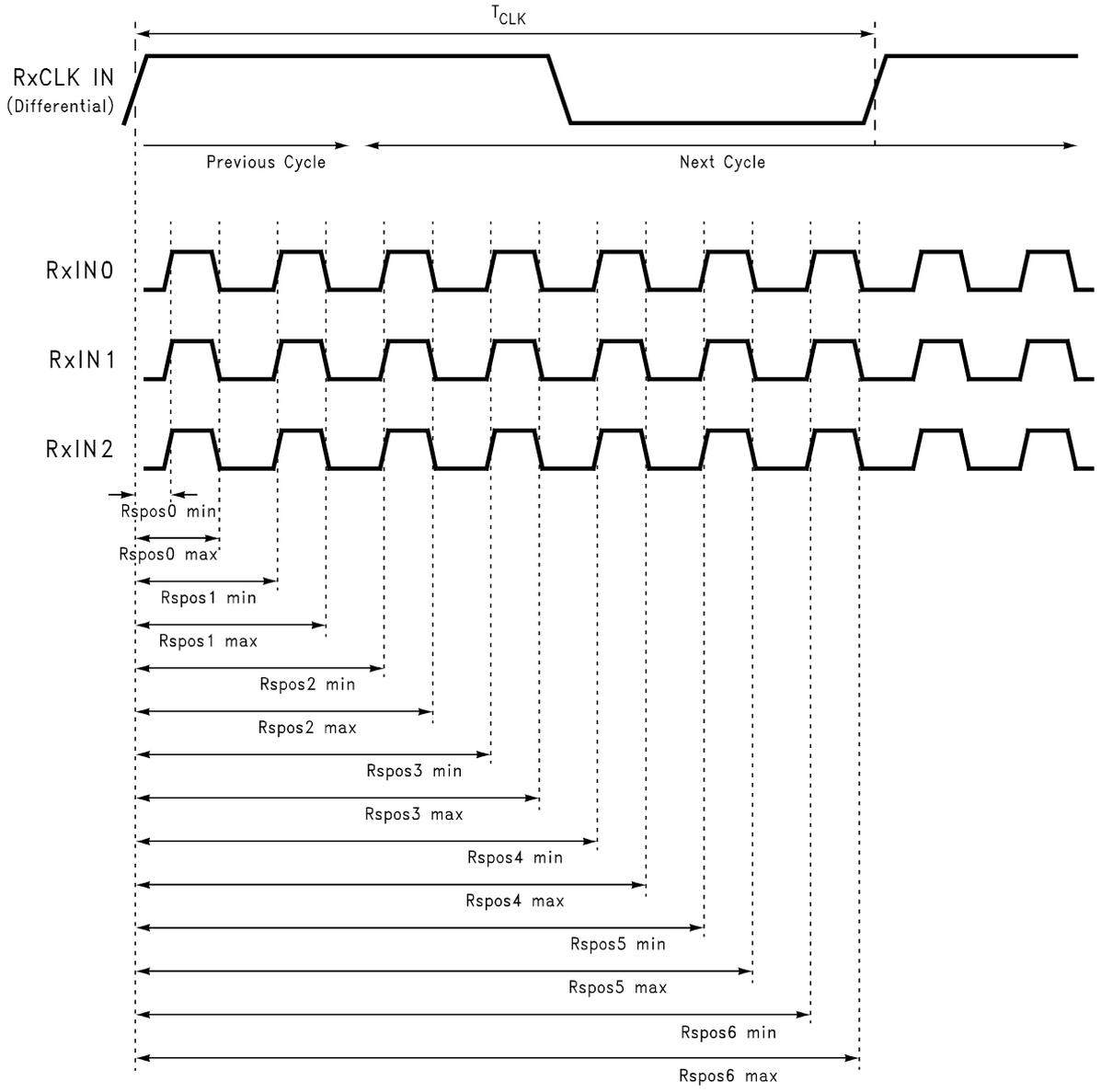
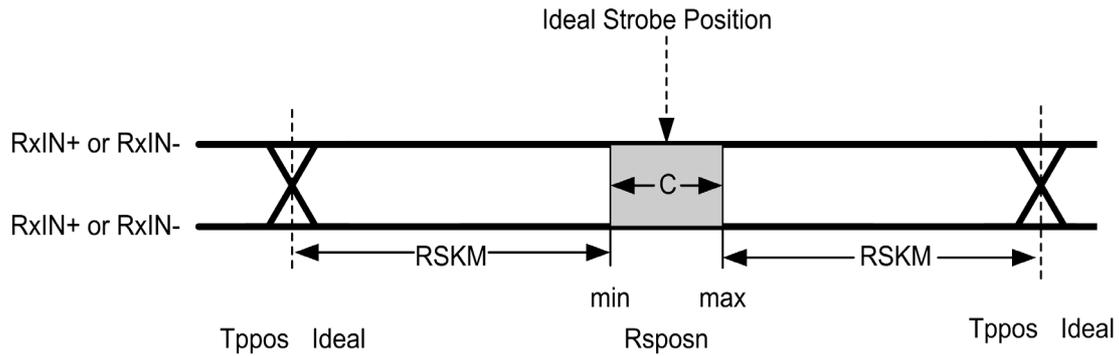


FIGURE 8. Receiver LVDS Input Strobe Position

AC タイミング図 (つぎ)



C - セットアップ / ホールドタイム (内部データ・サンプリング長) は R_{spos} (レシーバ入力ストロブ・ポジション) min と max により定義されます。

T_{ppos} - トランスミッタ出力パルス・ポジション

$RSKM$ ケーブル・スキュー + ソース・クロック・ジッタ (連続する2クロック間) (Note 6) + ISI (伝送波形干渉) (Note 7)

+ $TPPOS$ のばらつき (Tx 依存)

Note 6: クロック・ジッタは 85MHz で 250ps 以下。

Note 7: ISI は内部配線によります。

FIGURE 9. Receiver LVDS Input Skew Margin

アプリケーション情報

DS90CR218A ピン説明 - チャネル・リンク・レシーバ

ピン名	I/O	No.	説明
RxIN +	I	3	正の LVDS 差動データ入力
RxIN -	I	3	負の LVDS 差動データ入力
RxOUT	O	21	TTL レベルデータ出力。
RxCLK IN +	I	1	正の LVDS 差動クロック入力
RxCLK IN -	I	1	負の LVDS 差動クロック入力
RxCLK OUT	O	1	TTL レベルのクロック出力。立ち上がりエッジがデータ取り込みに使用されます。ピン名は RxCLK OUT です。
$\overline{PWR\ DWN}$	I	1	TTL レベル入力。入力が LOW にアサートされると、レシーバ出力は LOW になります。
V_{CC}	I	4	TTL 出力用の電源ピン
GND	I	5	TTL 出力用のグラウンド・ピン
PLL V_{CC}	I	1	PLL 用の電源ピン
PLL GND	I	2	PLL 用のグラウンド・ピン
LVDS V_{CC}	I	1	LVDS 入力用の電源ピン
LVDS GND	I	3	LVDS 入力用のグラウンド・ピン

チャネルリンクはいろいろなデータ送受信システムでの使用を目的に開発されました。システムにより接続する部材は異なります。例えば低速でかつケーブル長も短い (< 2m) 場合には、部材の電気的性能はそれほど重要とはなりません。高速かつ長距離のアプリケーションでは部材の性能が重要となります。実際、ケーブルの構成によりスキュー (ペア間における接続点間の電気的な線長差) を低減できます。例えば、TWIN-COAX では 5m で 1.785Gbit/s の伝送実績があります。より詳しい内容は以下のアプリケーション・ノートを参照ください。

AN = ####	Topic
AN-1041	Introduction to Channel Link
AN-1108	Channel Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
AN-1109	Multi-Drop Channel-Link Operation
AN-806	Transmission Line Theory
AN-905	Transmission Line Calculations and Differential Impedance
AN-916	Cable Information

アプリケーション情報 (つぎ)

ケーブル

トランスミッタとレシーバのインタフェースに用いられている差動の LVDS 信号はケーブルにより伝送されます。21 ビット・チャネルリンクチップセット (DS90CR217/218A) では 4 ペアの信号線が、28 ビット・チャネルリンク・チップセット (DS90CR287/288A) では 5 ペアの信号線が必要となります。理想的なケーブル/コネクタのインタフェースは伝送路すべてにわたり 100 Ω 一定の差動インピーダンスに保つことです。また、レシーバで十分なデータのサンプルウィンドウを確保するために 90ps (85MHz 時) 以下にスキューを抑えてください。

さらに、データとクロックを伝送する 4 または 5 ペアのケーブルに最低 1 本 (または 1 ペア) のグラウンドを用意することを推奨します。このグラウンドによりコモンモードのリターンパスを構成することができます。一対一のアプリケーションで一般的に使用されているケーブルにはフラット、フレックス、ツイストペア、TWIN-COAX がああります。構成やオプションによりさまざまなケーブルが用意されています。フラット、フレックス、ツイストペアは短い一対一のアプリケーションには十分です。TWIN-COAX は長短どちらでも高い性能を示します。フラットケーブル使用時には各差動信号間にグラウンド線を入れることを推奨します。このグラウンドにより、近接するペア間のノイズによる干渉を防げます。TWIN-COAX ケーブルでは各ケーブルペアをシールドすることを推奨します。一対一のアプリケーションで距離を伸ばす場合には、ケーブルのタイプによらず全ケーブルペアをシールドしてください。全体をシールドすると、EMS や EMI に起因する問題を解決し、長距離化、高速化といった伝送パラメータの向上になります。

いろいろなケーブルタイプで LVDS 信号はすばらしい性能を示しています。しかし、総合的に最高の性能となったのは TWIN-COAX ケーブルを使用したときでした。TWIN-COAX ケーブルはその構造とシールドの二重化により、優れたスキューと EMI 性能をもっています。ここに記載している情報と関連のアプリケーション・ノートには設計者に有用な数多くのガイドラインを載せています。設計者は各アプリケーションで安全かつ経済的なケーブルのためにさまざまなトレードオフを査定するよう推奨します。

レシーバ・フェイルセーフ機能

本レシーバは、レシーバ入力オープンまたは終端された状態でも安定したレシーバ出力を得るために、入力段にフェイルセーフのバイアス回路を備えています。これにより、前記のようにオープンまたは終端された状態でも、レシーバ出力は HIGH になります。し

たがって、クロック信号が有効であれば、すべてのデータ出力も HIGH になります。クロック信号がオープンまたは終端されていたとすると、レシーバ出力は最後の有効な状態を保持します。なおクロック入力がオープンまたは終端されていると、クロック出力は HIGH になります。

ボードレイアウト

LVDS の EMI、ノイズマージンを最大限活用するには差動信号のレイアウトに注意を払う必要があります。他の信号からのノイズによる干渉を抑え、差動信号のノイズキャンセル性能を有効に利用するために、差動信号ラインは常に近接していなければなりません。また、差動信号線長も等長になるようトレースを調整してください。あらゆる高速設計で、インピーダンスの不整合は避けなければなりません (ビアを減らす、90 度に曲がるトレースを避けるなど)。差動信号の一方ラインにインピーダンスの不整合があると他方の信号ラインにも影響が現れます。差動信号のトレースのインピーダンスは選択されたケーブルのインピーダンスと整合していなければなりません (このインピーダンスはレシーバ入力端で差動信号間に入れる終端抵抗とも一致していなければなりません)。最後に、チャネルリンクの TxOUT/RxIN ピンは、PCB 上での余分なトレースを避けるためにボードの端にできるだけ近づけてください。これらはすべて高速性や EMI に影響を与える反射やクロストークを抑制するものです。

未使用入力

RxOUT の未使用入力は、すべてグラウンドに接続するか未接続のままにしてください。レシーバの未使用入力は、オープンのままではかまいません。

終端

電流モードのドライバでは、レシーバの入力に終端抵抗が必要です。チャネルリンク・チップセットではレシーバ差動入力ペアの + と - ごとに 100 Ω の終端抵抗が必要です。実際の終端抵抗値は、ケーブルの差動特性インピーダンス (90 ~ 120 Ω) と同じになるように選択します。Figure 18 の例を参照ください。PECL のような他の差動信号と異なり、プルアップやプルダウンの抵抗も必要ありません。リードのインダクタンスを減らすために表面実装タイプの抵抗を推奨します。終端抵抗は差動信号を効果的に終端し、スタブを短くするためにレシーバ入力ピンのできるだけ近くに配置してください。

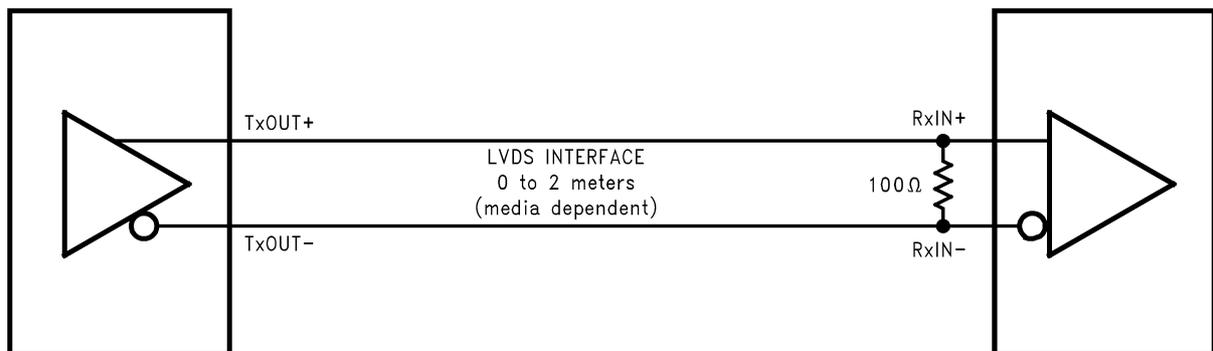


FIGURE 10. LVDS Serialized Link Termination

アプリケーション情報 (つづき)

デカップリング・コンデンサ

性能を制限するスイッチング・ノイズを低減するために、バイパス・コンデンサを入れてください。各 V_{CC} と GND に 3 個並列にデカップリング・コンデンサ (多層セラミックの面実装タイプ) を挿入されることを推奨します (Figure 19)。3 個のコンデンサの値は $0.1\mu\text{F}$ 、 $0.01\mu\text{F}$ 、 $0.001\mu\text{F}$ です。電源とグラウンドはできるだけ幅広いトレースを使用し各コンデンサはそれぞれ個別にグラウンド接続してください。ボード上に十分なスペースがない場合、PLL V_{CC} 、LVDS V_{CC} 、ロジック V_{CC} の順に優先してください。

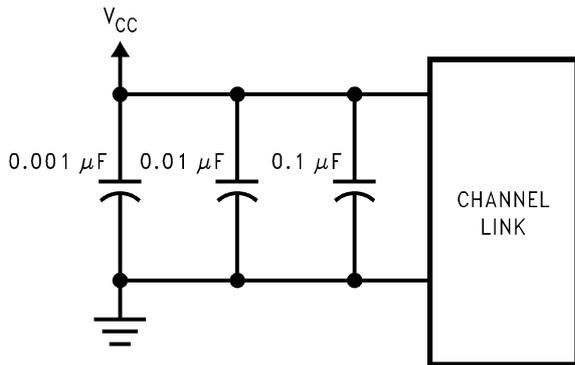


FIGURE 11. CHANNEL LINK
Decoupling Configuration

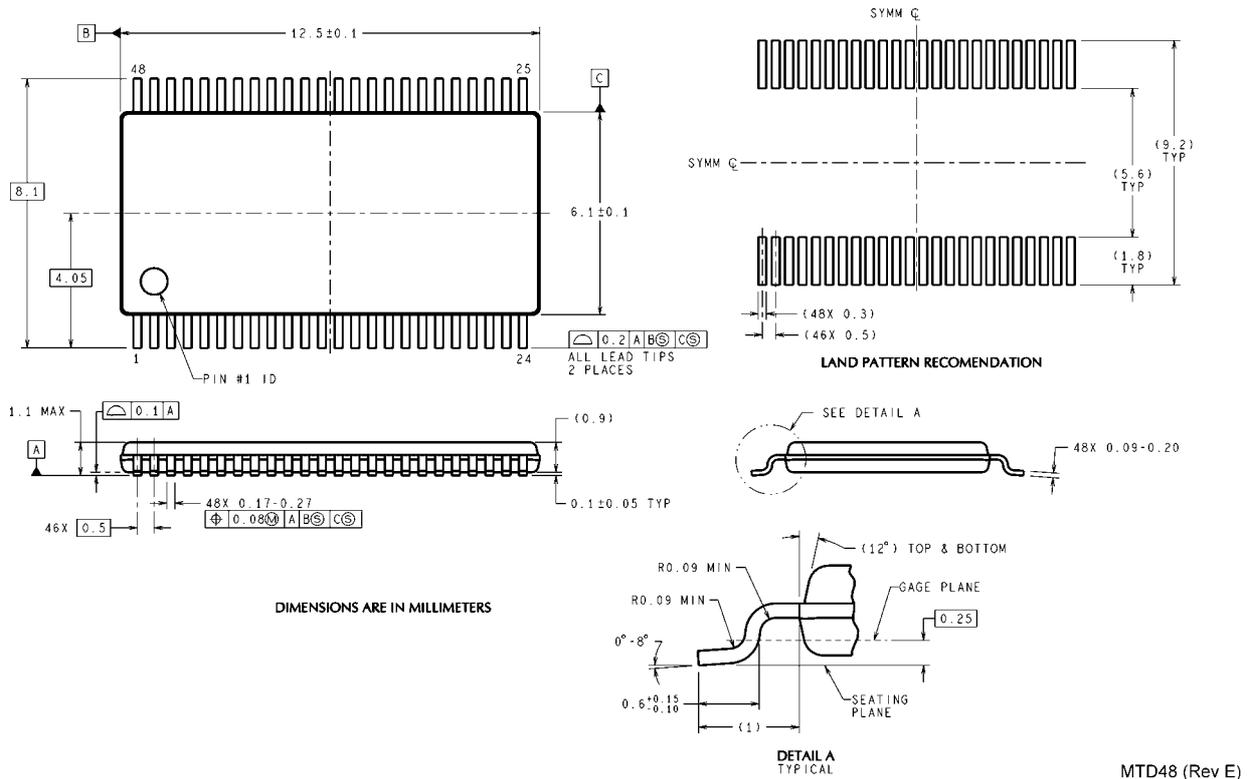
クロックジッタ

チャンネルリンクでは、PLL により LVDS を介して送られてきたクロックを再生します。LVDS 上のシリアル化されたデータ 1 ビットの幅は、クロックの $1/7$ となります。例えば、 85MHz クロックでは周期は約 11.76ns 、1 ビットのデータ幅は 1.68ns となります。差動スキュー (1 差動ペア内の t)、接続スキュー (差動ペア間の t)、クロックジッタはシリアル化されたデータをサンプリングするマージンを減少させる要因となります。トランスミッタへ入力するクロックはできるだけきれいなクロックを入力してください。各 V_{CC} ごとのデカップリング・コンデンサにより内部 PLL へ回り込むジッタを低減でき、LVDS クロックのジッタも低減できます。全体のジッタ、スキューのマージンの割り振りにここでの測定が役立ちます。

ノイズマージン

通常、LVDS 信号は $+1.2\text{V}$ を振幅の中心として、信号振幅 300mV です。チャンネルリンク・レシーバは 100mV のスレッショルド範囲を持っているため、 200mV の差動ノイズマージンとなります。差動信号によるデータ転送では共通モードの対策がシステムではより重要です。LVDS レシーバの入力範囲はグラウンドから $+2.4\text{V}$ です。つまり、グラウンドレベルの違いや共通モード・ノイズにより振幅の中心が $\pm 1\text{V}$ の変動が許されています。

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)



Order Number DS90CR218AMTD
Dimensions in millimeters only
NS Package Number MTD48

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター 製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売が使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

生命維持装置への使用について

ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2007 National Semiconductor Corporation
 製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 (日本語 / 英語) はホームページより入手可能です。

www.national.com/jpn/

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されてもありません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されてもありません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上